

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 3 区分

【発行日】平成20年4月24日(2008.4.24)

【公表番号】特表2007-529580(P2007-529580A)

【公表日】平成19年10月25日(2007.10.25)

【年通号数】公開・登録公報2007-041

【出願番号】特願2007-503233(P2007-503233)

【国際特許分類】

C 0 8 G 18/79 (2006.01)

C 0 8 G 18/67 (2006.01)

C 0 8 G 18/16 (2006.01)

C 0 8 F 299/06 (2006.01)

C 0 9 D 175/14 (2006.01)

C 0 9 D 4/00 (2006.01)

C 0 9 D 7/12 (2006.01)

【F I】

C 0 8 G 18/79 A

C 0 8 G 18/67

C 0 8 G 18/16

C 0 8 F 299/06

C 0 9 D 175/14

C 0 9 D 4/00

C 0 9 D 7/12

【手続補正書】

【提出日】平成20年3月4日(2008.3.4)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

化学放射線への暴露によりエチレン性不飽和化合物と重合を伴って反応する活性化基を有する有機基を、2つの単結合を介して結合されたアロファネート基の酸素原子に含む、アロファネート基含有バインダーの製造方法であって、

A) ウレトジオン基含有化合物 1 種又はそれ以上を、

B) 化学放射線への暴露によりエチレン性不飽和化合物と重合を伴って反応する基を有する OH 官能性化合物 1 種又はそれ以上、および

C) 所望により更に、NCO 反応性化合物と、

D) 触媒としての、フェノキシド基含有化合物 1 種又はそれ以上、及び

E) 所望により、助剤及び添加剤の存在下に、

反応させる、製造方法。

【請求項 2】

成分 A) のウレトジオン基含有化合物は、ヘキサメチレンジイソシアネートに基づく化合物である、請求項 1 に記載のアロファネート基含有バインダーの製造方法。

【請求項 3】

成分 B) として、2 - ヒドロキシエチルアクリレート及び / 又は 4 - ヒドロキシブチルアクリレートを使用する、請求項 1 又は 2 に記載のアロファネート基含有バインダーの製

造方法。

【請求項 4】

成分 D) の触媒として、テトラブチルアンモニウム 4 - (メトキシカルボニル)フェノキシド、テトラブチルアンモニウム 2 - (メトキシカルボニル)フェノキシド、テトラブチルアンモニウム 4 - ホルミルフェノキシド、テトラブチルアンモニウム 4 - ニトリルフェノキシド、テトラブチルホスホニウム 4 - (メトキシカルボニル)フェノキシド、テトラブチルホスホニウム 2 - (メトキシカルボニル)フェノキシド、テトラブチルホスホニウム 4 - ホルミルフェノキシド、テトラブチルアンモニウムサリチレート及び / 又はテトラブチルホスホニウムサリチレートを使用する、請求項 1 ~ 3 のいずれかに記載のアロファネート基含有バインダーの製造方法。

【請求項 5】

請求項 1 ~ 4 のいずれかに記載の方法により得られる、化学放射線への暴露によりエチレン性不飽和化合物と重合を伴って反応する基を有するアロファネート基含有バインダー。

【請求項 6】

- a) 請求項 5 に記載のアロファネート基含有バインダー 1 種又はそれ以上
 - b) 所望により、化学放射線への暴露によりエチレン性不飽和化合物と重合を伴って反応する基を有さない、遊離又はブロックトイソシアネート基含有ポリイソシアネート 1 種又はそれ以上
 - c) 所望により、化学放射線への暴露によりエチレン性不飽和化合物と重合を伴って反応する基及び任意に遊離又はブロックトイソシアネート基を有する、a) とは異なる他の化合物、
 - d) 所望により、活性水素原子を有するイソシアネート反応性化合物 1 種又はそれ以上、
 - e) 開始剤、
 - f) 所望により、溶媒、並びに
 - g) 所望により、助剤及び添加剤
- を含んでなる被覆組成物。

【請求項 7】

請求項 5 に記載のアロファネート基含有バインダーから得られる被覆により塗装された基材。